

LAPT

2SC2837

シリコンNPNエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SA1186とコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

■絶対最大定格 (Ta=25°C)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	150	V
V _{CE0}	150	V
V _{EB0}	5	V
I _C	10	A
I _B	2	A
P _C	100(T _C =25°C)	W
T _J	150	°C
T _{stg}	-55~+150	°C

■電気的特性 (Ta=25°C)

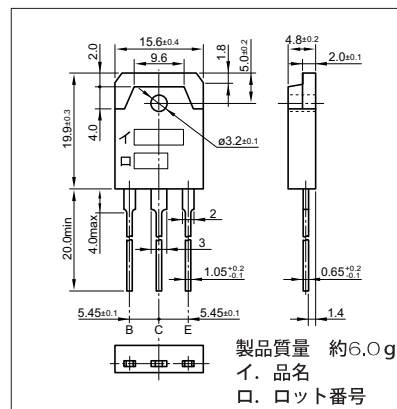
記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} =150V	100max	μA
I _{EB0}	V _{EB} =5V	100max	μA
V(BR) _{CEO}	I _C =25mA	150min	V
h _{FE}	V _{CE} =4V, I _C =3V	50min※	
V _{CE(sat)}	I _C =5A, I _B =0.5A	2.0max	V
f _r	V _{CE} =12V, I _E =-1A	70typ	MHz
C _{OB}	V _{CB} =80V, f=1MHz	60typ	pF

※ランク O(50~100), P(70~140), Y(90~180)

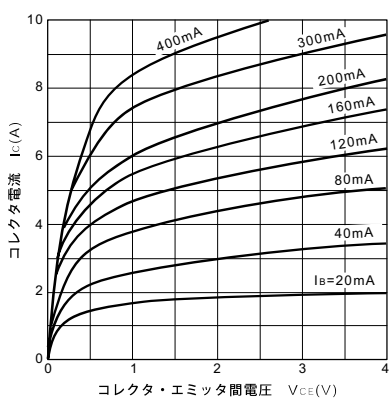
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{B2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
60	12	5	-5	500	-500	0.2typ	1.4typ	0.35typ

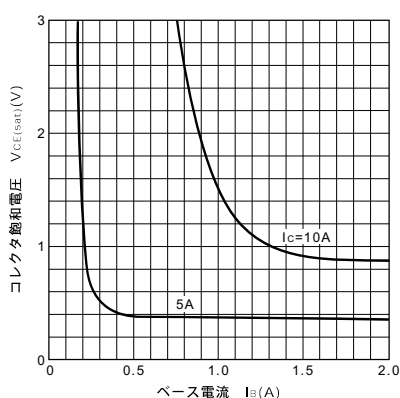
外形図 MT-100(TO3P)



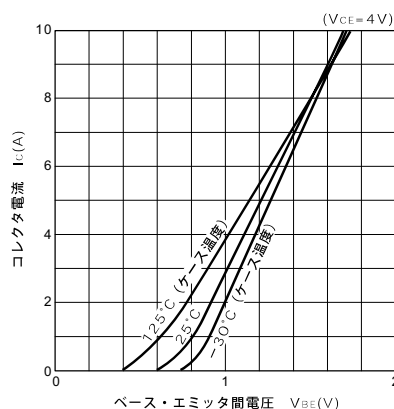
I_C-V_{CE}特性 (代表例)



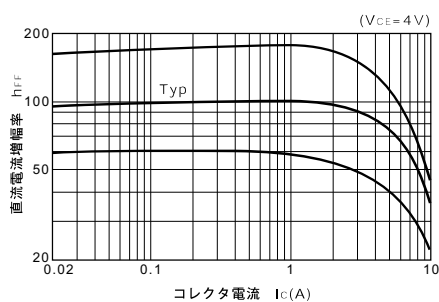
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



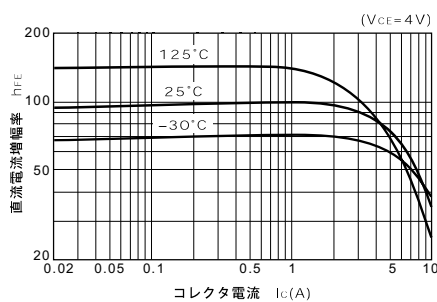
I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)



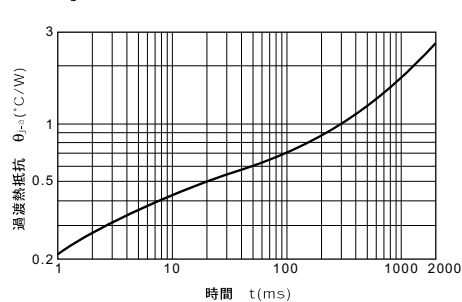
h_{FE}-I_C特性 (代表例)



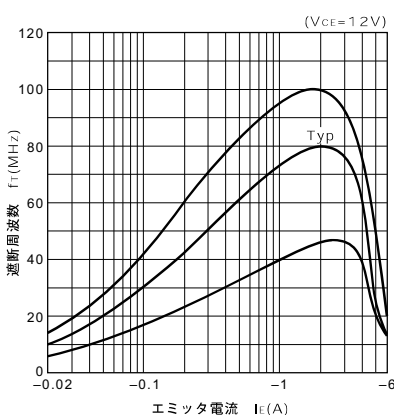
h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)



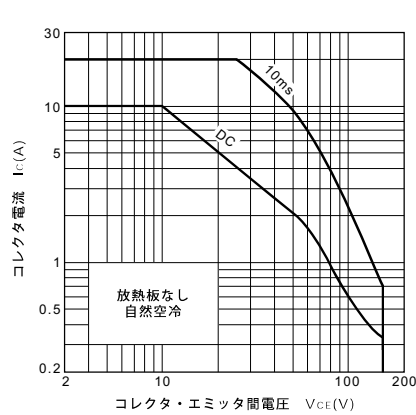
θ_{J-a}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_C-T_a定格

